

	<p>SIB413DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIB413DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p> <p>Datenblätter:  SIB413DK-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB413DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 6.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Andere Namen	SIB413DK-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	357pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.63nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

SIB413DK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB413DK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB413DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIB413DK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB411DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB413DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB412DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB415DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>
 <p>SIB414DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p>	 <p>SIB415DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB414DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p>	 <p>SIB412DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB413DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB413DK-T1-GE3 Datenblatt	SIB413DK-T1-GE3-Datenblätter	SIB413DK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB413DK-T1-GE3
SIB413DK-T1-GE3 Electronic	SIB413DK-T1-GE3-Komponenten	SIB413DK-T1-GE3-Verteiler	SIB413DK-T1-GE3-Bild	SIB413DK-T1-GE3-Teil
SIB413DK-T1-GE3 Preis	SIB413DK-T1-GE3 Hersteller	SIB413DK-T1-GE3 Bild	SIB413DK-T1-GE3 Aktie	SIB413DK-T1-GE3 Inventar
SIB413DK-T1-GE3 Neu	SIB413DK-T1-GE3 Original	SIB413DK-T1-GE3 garantiert	SIB413DK-T1-GE3 RFQ	SIB413DK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited